

现货 MMIC 滤波器

名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLD000001-L-1K	0MHz	100MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	1
滤波器	WLD000001-LK	0MHz	180MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	2
滤波器	WLD000003-L-1K	0MHz	300MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	3
滤波器	WLD000011-LK	0MHz	1100MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	4
滤波器	WLD000015-LK	0MHz	1500MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	5
滤波器	WLD000020-LK	0MHz	2000MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	6
滤波器	WLD000023-LK	0MHz	2300MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	7
滤波器	WLD000040-L-1K	0MHz	4400MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	8
滤波器	WLD000050-L-1K	0MHz	5000MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	9
滤波器	WLD000080-LK	0MHz	8000MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	10
滤波器	WLD000100-L-1K	0MHz	10000MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	11
滤波器	WLD000120-LK	0MHz	11500MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	12
滤波器	WLD000160-L-1K	0MHz	16400MHz	低通	芯片滤波器	MMIC	13
滤波器	WLD003020-HK	350MHz	2000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	14
滤波器	WLD010080-HK	1050MHz	8000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	15
滤波器	WLD029180-HK	2900MHz	18000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	16
滤波器	WLD100400-HK	10000MHz	40000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	17
滤波器	WLD120400-HK	12500MHz	40000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	18
滤波器	WLD140400-HK	14200MHz	40000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	19
滤波器	WLD141400-HK	14300MHz	40000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	20
滤波器	WLD240400-HK	24000MHz	40000MHz	高通	芯片滤波器	MMIC	21
滤波器	WLD003006K	350MHz	550MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	22
滤波器	WLD004005K	460MHz	540MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	23
滤波器	WLD009013K	900MHz	1250MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	24
滤波器	WLD010033K	950MHz	3300MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	25



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLD013015K	1250MHz	1450MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	26
滤波器	WLD013020K	1300MHz	2150MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	27
滤波器	WLD014031K	1400MHz	3050MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	28
滤波器	WLD017019K	1700MHz	1900MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	29
滤波器	WLD020028K	1950MHz	2850MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	30
滤波器	WLD023025K	2250MHz	2550MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	31
滤波器	WLD026028K	2550MHz	2850MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	32
滤波器	WLD026046-2K	2600MHz	4600MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	33
滤波器	WLD027062K	2700MHz	6200MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	34
滤波器	WLD029031K	2850MHz	3150MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	35
滤波器	WLD035037K	3475MHz	3725MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	36
滤波器	WLD037041K	3700MHz	4150MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	37
滤波器	WLD038048K	3850MHz	4900MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	38
滤波器	WLD042044K	3900MHz	4800MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	39
滤波器	WLD044050K	3950MHz	6050MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	40
滤波器	WLD043047K	4360MHz	4640MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	41
滤波器	WLD051058K	5150MHz	5850MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	42
滤波器	WLD060066K	6000MHz	6600MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	43
滤波器	WLD095125K	8900MHz	11800MHz	带通	芯片滤波器	MMIC	44



产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

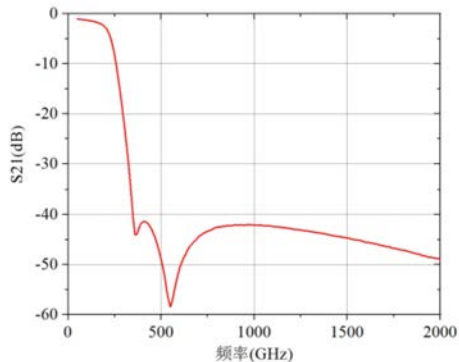
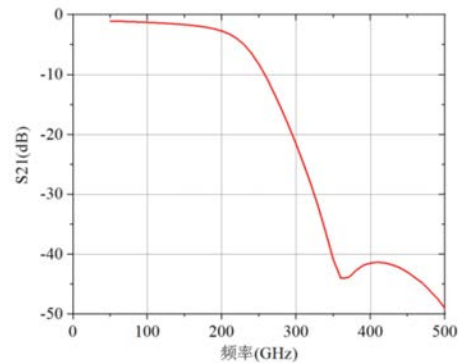
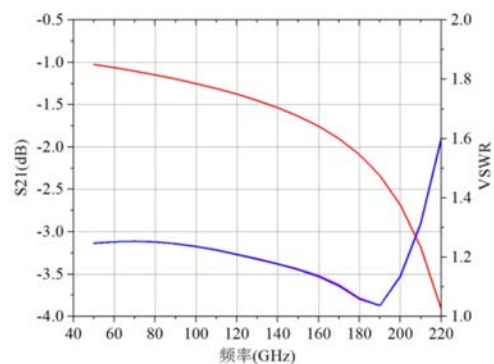
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	100	MHz
中心损耗	/	/			1.3	dB
带外抑制	310	MHz≥	20			dBc
带外抑制	0.4-2	GHz≥		40		dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
时延波动	≤0.9ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

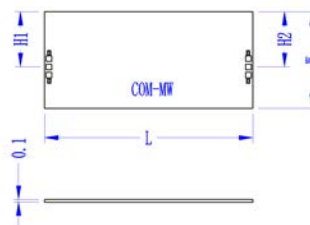
典型测试曲线图



参考实物图

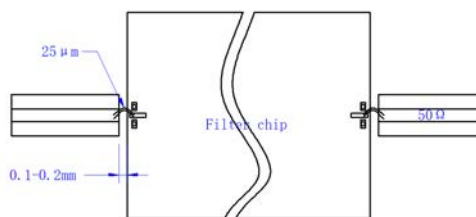


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.35	1.4	1.45
W	1.15	1.2	1.25
H1		0.6	
H2		0.6	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

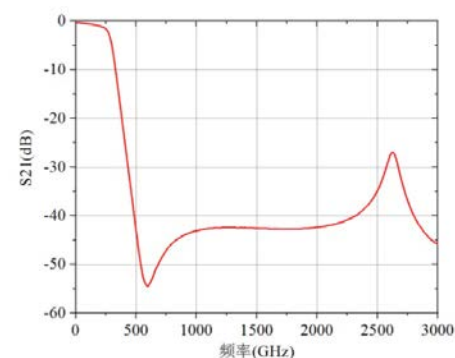
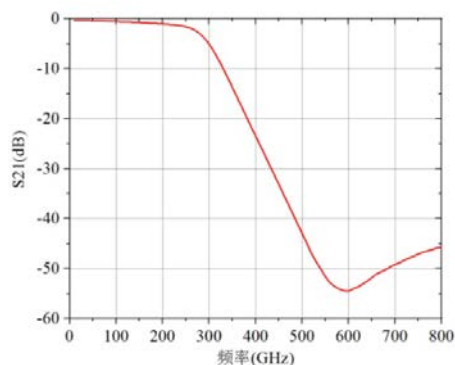
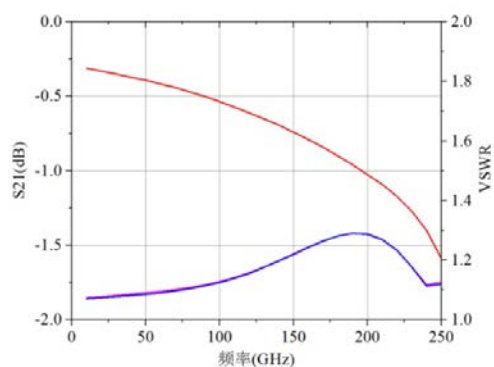
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	180	MHz
中心损耗	/	/			1	dB
带外抑制	400	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

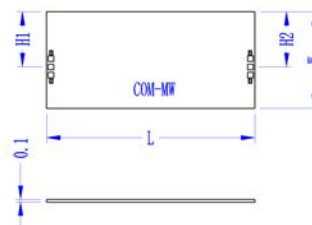
典型测试曲线图



参考实物图

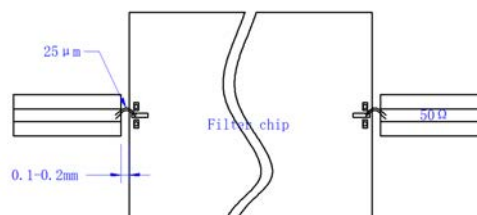


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.75	2.8	2.85
W	1.55	1.6	1.65
H1		0.8	
H2		0.8	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

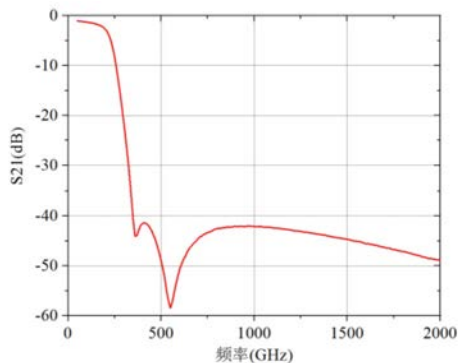
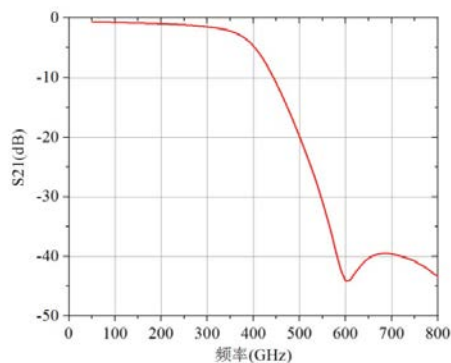
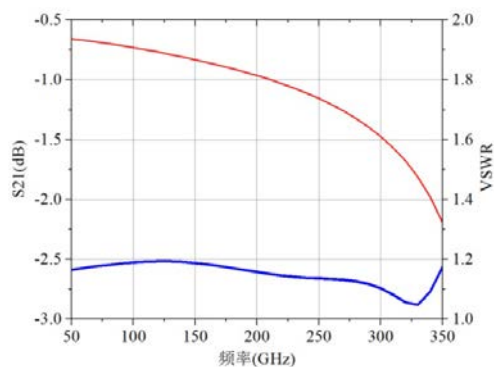
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	300	MHz
中心损耗	/	/			1.7	dB
带外抑制	530	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

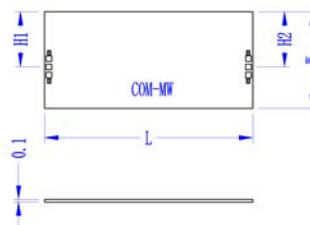
典型测试曲线图



参考实物图

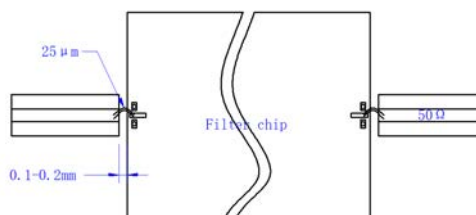


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.15	1.2	1.25
W	1.15	1.2	1.25
H1		0.6	
H2		0.6	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

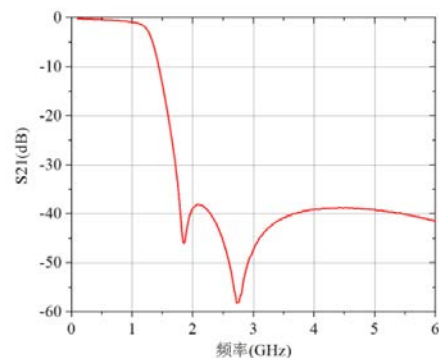
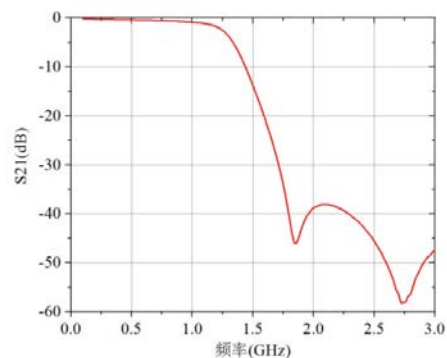
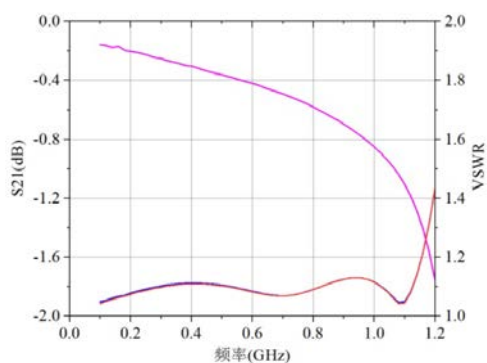
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	1100	MHz
中心损耗	/	/			1.3	dB
带外抑制	1680	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

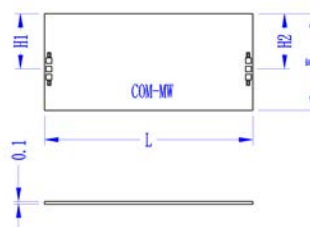
典型测试曲线图



参考实物图

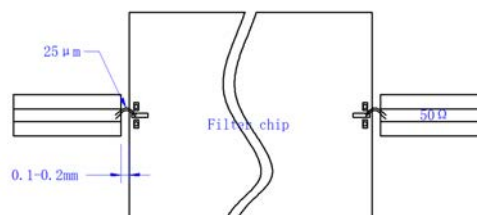


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.25	1.3	1.35
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

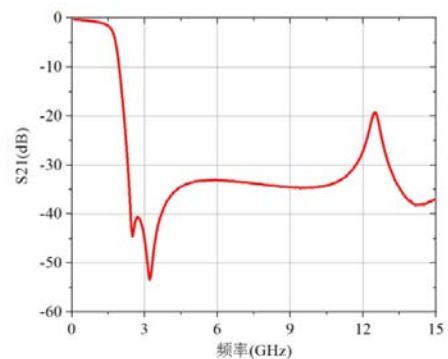
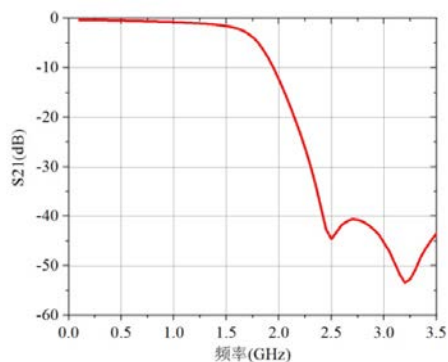
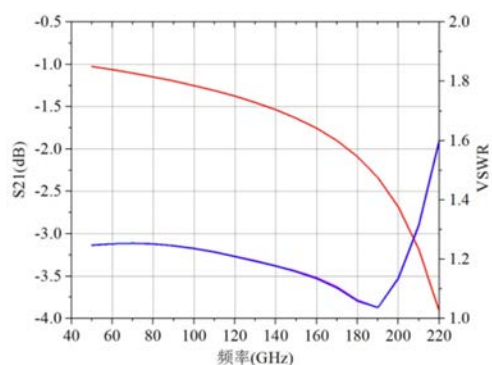
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	1500	MHz
中心损耗	/	/			1.7	dB
带外抑制	2250	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

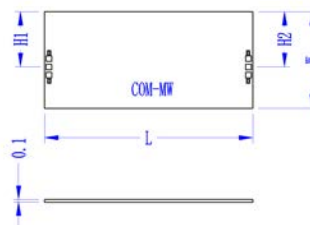
典型测试曲线图



参考实物图

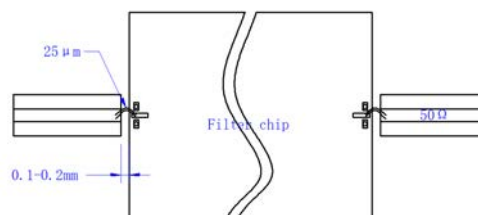


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.95	1	1.05
W	0.7	0.75	0.8
H1		0.32	
H2		0.32	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

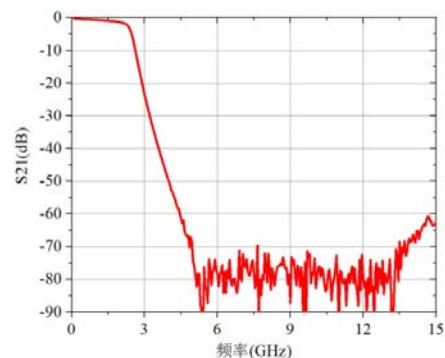
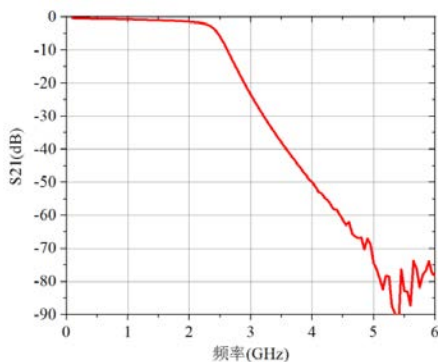
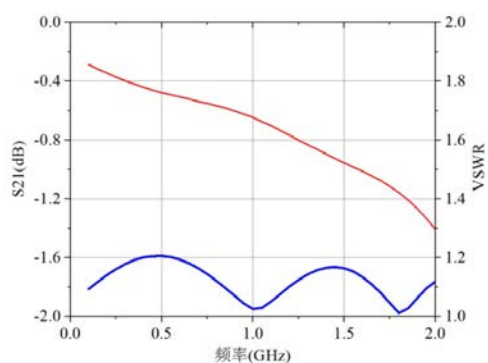
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	2000	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带外抑制	3050	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

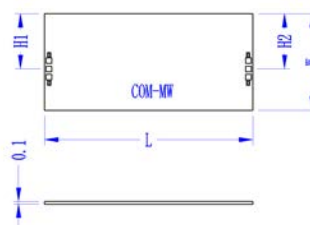
典型测试曲线图



参考实物图

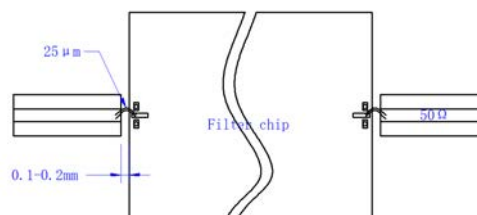


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.35	2.4	2.45
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.5	
H2		0.5	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

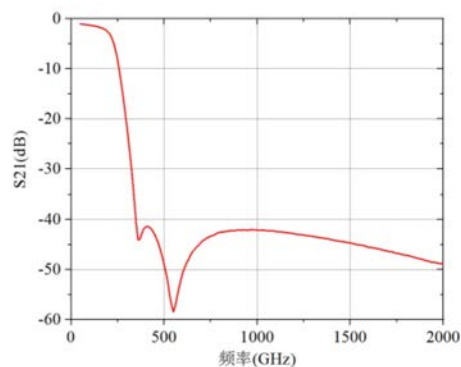
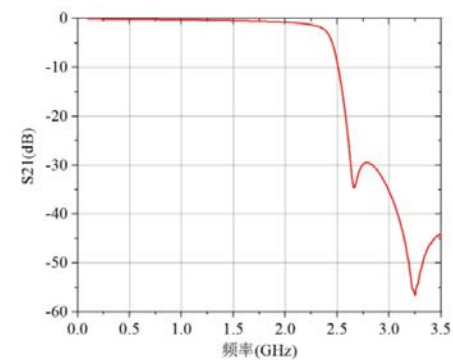
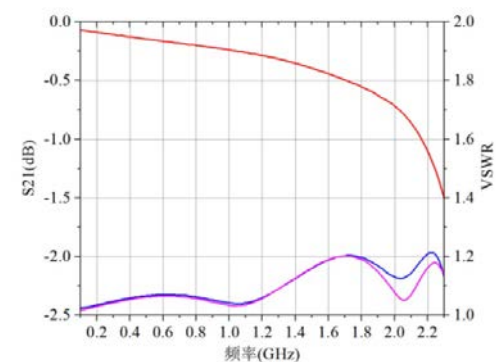
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	2300	MHz
中心损耗	/	/			2.2	dB
带外抑制	2600	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

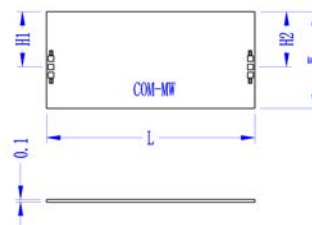
典型测试曲线图



参考实物图

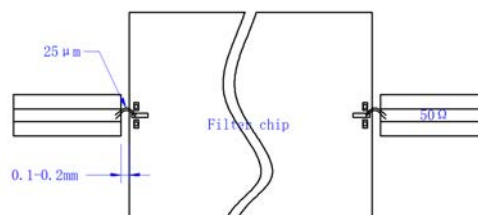


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.45	2.5	2.55
W	1.95	2.0	2.05
H1		0.85	
H2		0.85	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

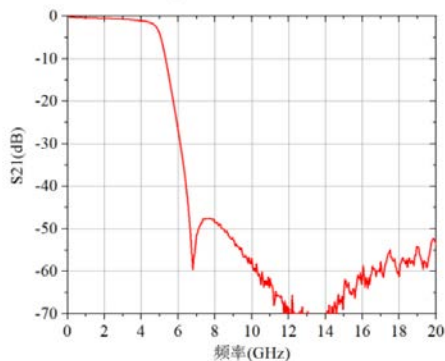
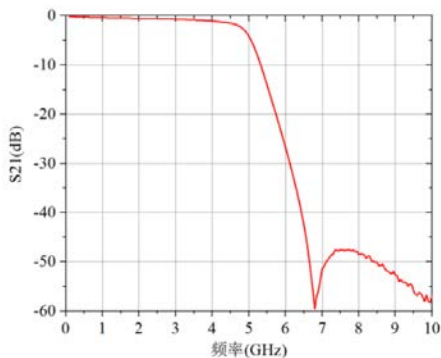
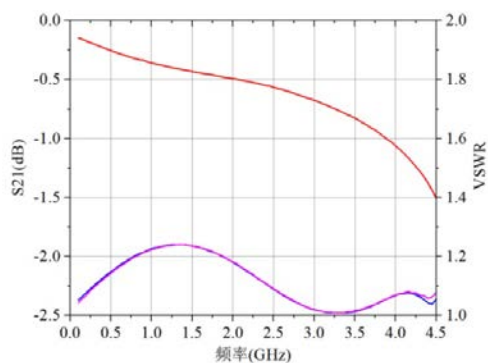
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	4400	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带外抑制	6000	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

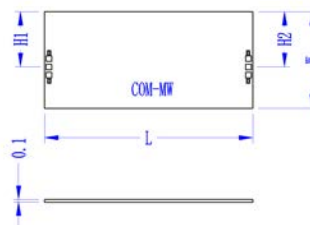
典型测试曲线图



参考实物图

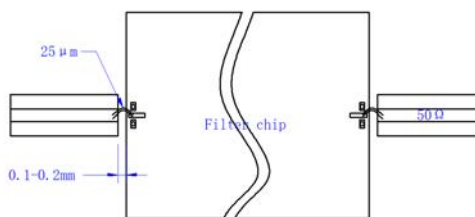


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.55	1.6	1.65
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

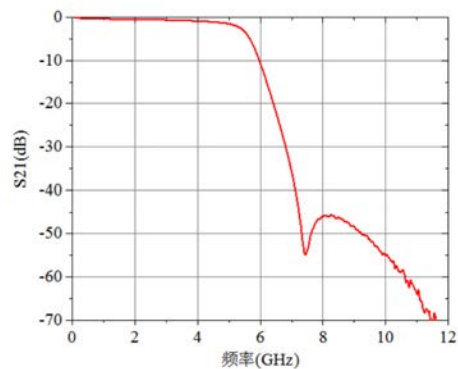
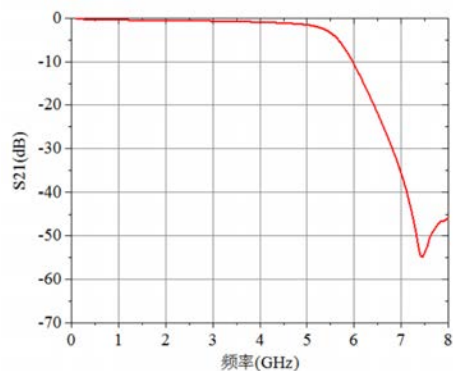
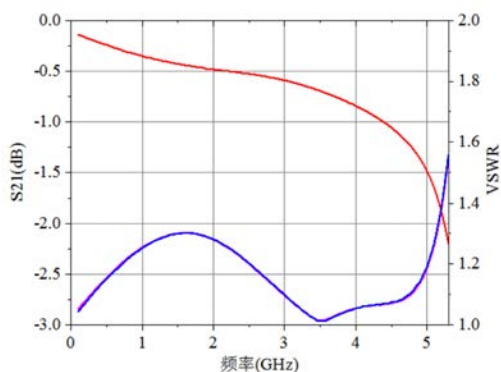
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	5000	MHz
中心损耗	/	/			1.75	dB
带外抑制	6900	MHz≥	28			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

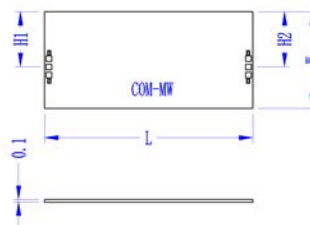
典型测试曲线图



参考实物图

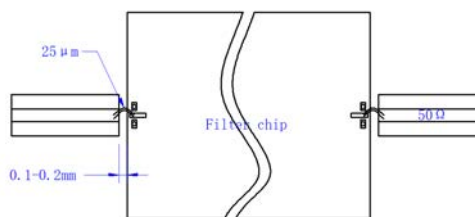


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.55	1.6	1.65
W	0.65	0.7	0.75
H1		0.3	
H2		0.3	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

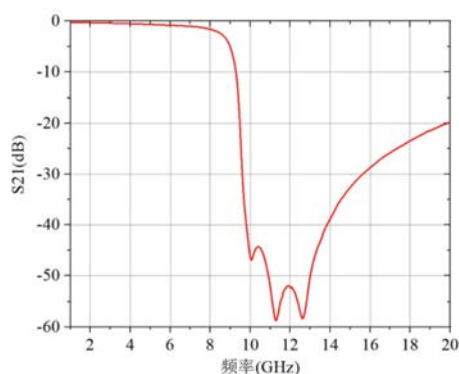
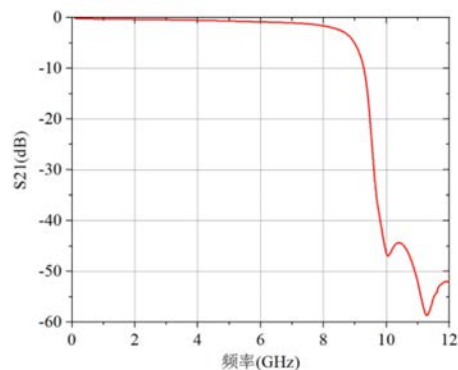
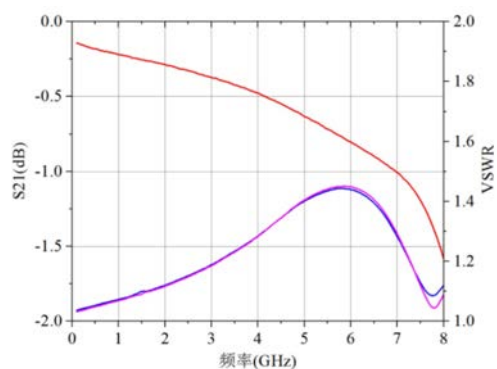
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	8000	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带外抑制	9700	MHz≥	25			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

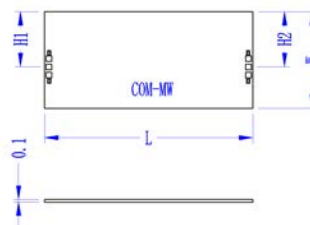
典型测试曲线图



参考实物图

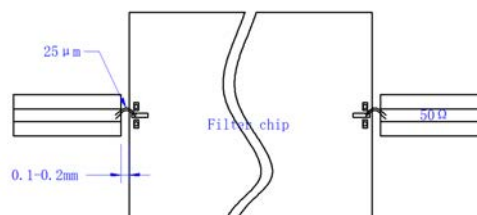


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.45	1.5	1.55
W	0.9	0.95	1
H1		0.48	
H2		0.48	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

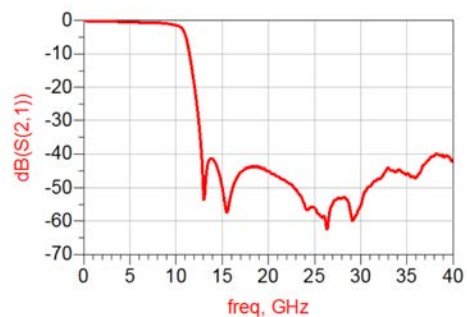
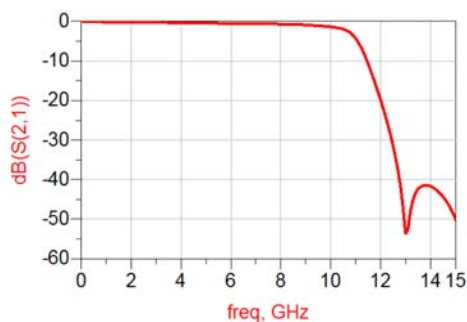
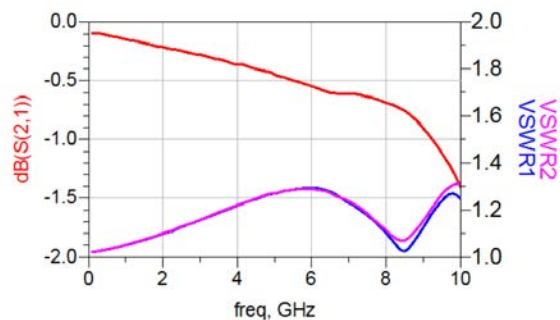
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	10000	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带外抑制	12800	MHz $\geq$	30			dBc
带外抑制	13100	MHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

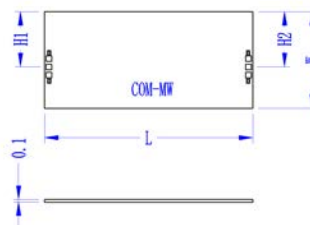
典型测试曲线图



参考实物图

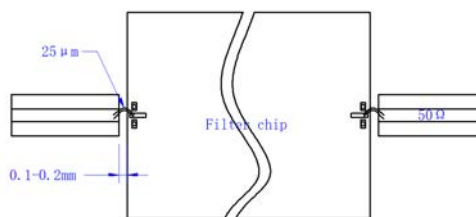


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.45	1.5	1.55
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

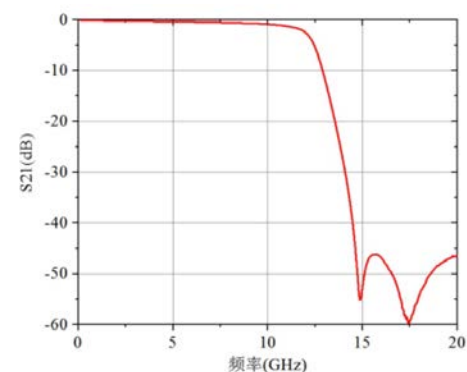
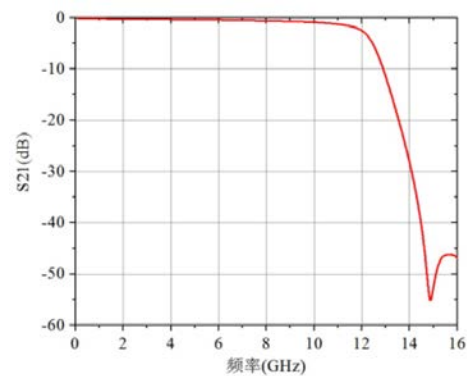
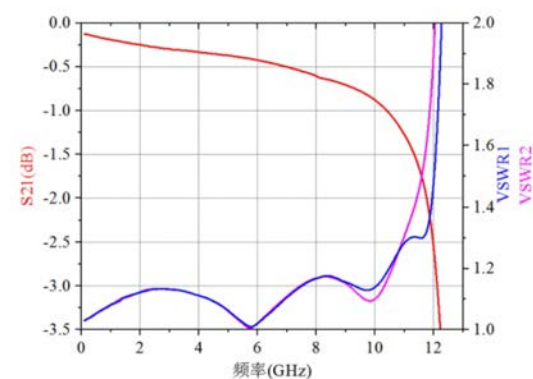
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	11500	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带外抑制	14050	MHz $\geq$	20			dBc
带外抑制	14900	MHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

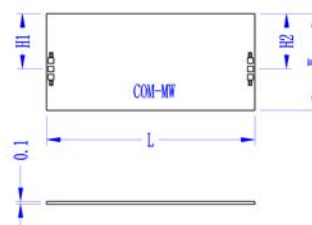
典型测试曲线图



参考实物图

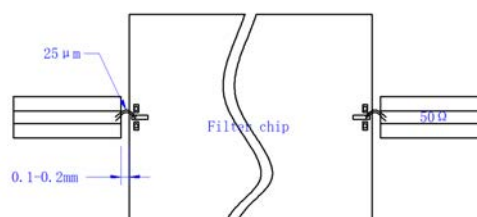


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.45	1.5	1.55
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

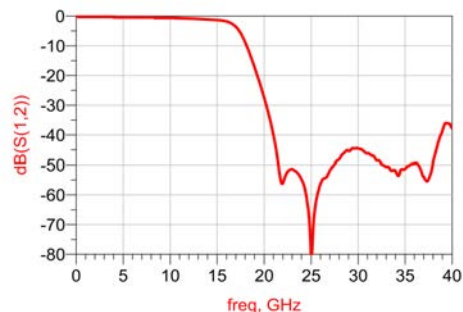
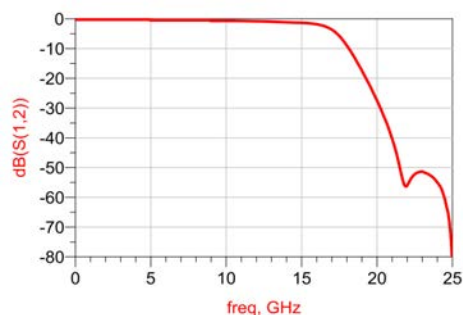
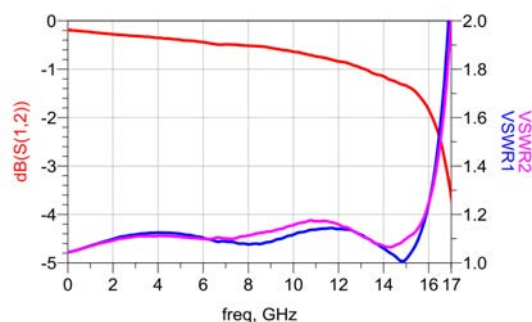
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	16400	MHz
中心损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	20400	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

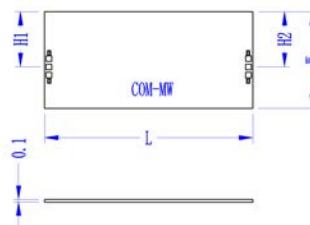
典型测试曲线图



参考实物图

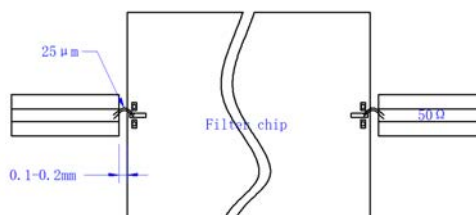


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.9	1.0	1.1
W	0.54	0.64	0.74
H1		0.32	
H2		0.32	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

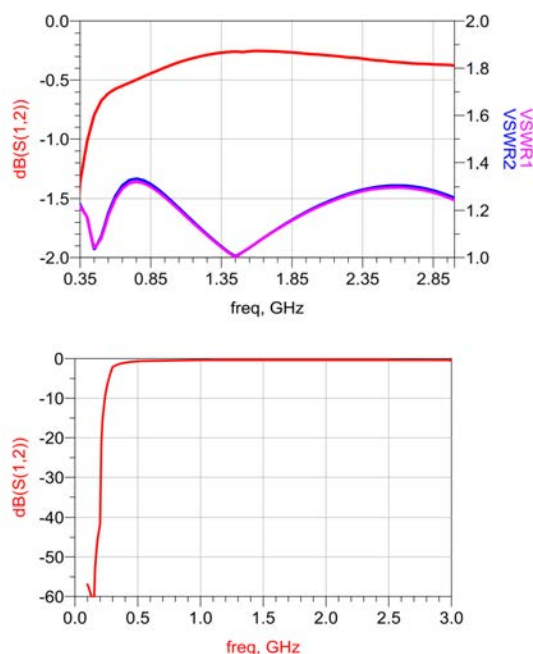
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	350	~	2000	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	200	MHz≥	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

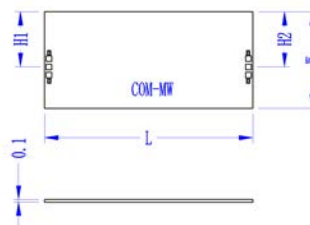
典型测试曲线图



参考实物图

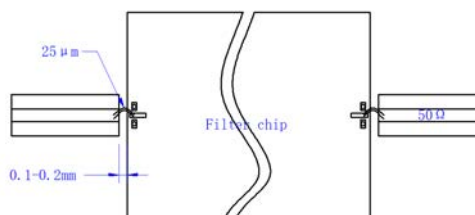


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.95	2.0	2.05
W	2.45	2.5	2.55
H1		1.25	
H2		1.25	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

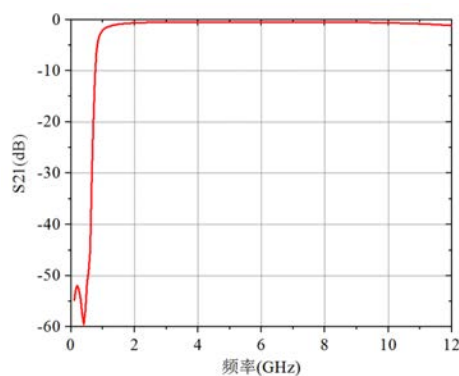
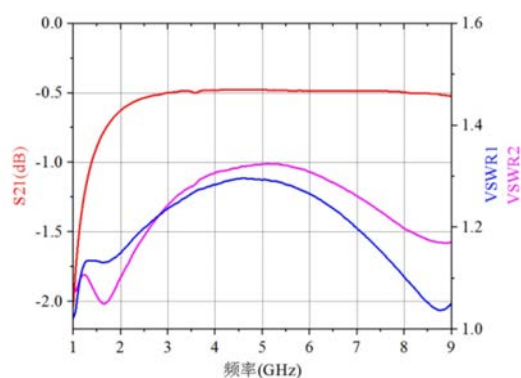
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1050	~	8000	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	600	MHz≥	38			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

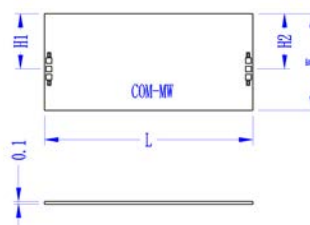
典型测试曲线图



参考实物图

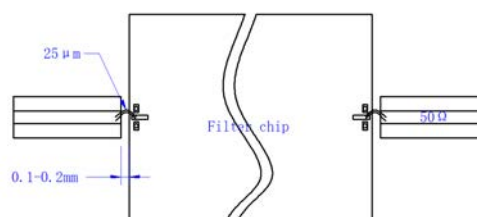


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.55	1.6	1.65
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.4	
H2		0.4	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

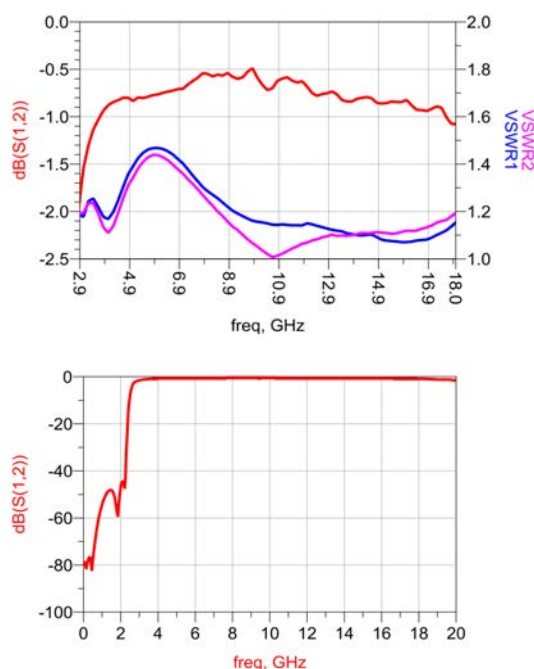
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2900		18000	MHz
中心损耗	/	/			2.1	dB
带外抑制	2300	MHz $\geq$	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

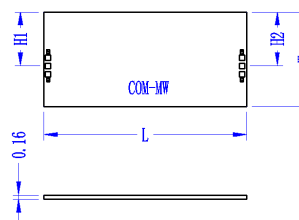
典型测试曲线图



参考实物图

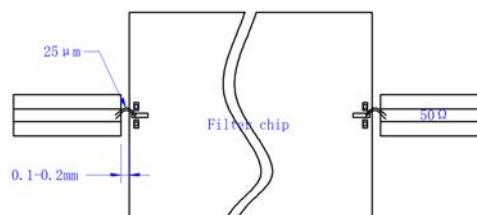


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.95	2.0	2.05
W	1.45	1.5	1.55
H1		0.75	
H2		0.75	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

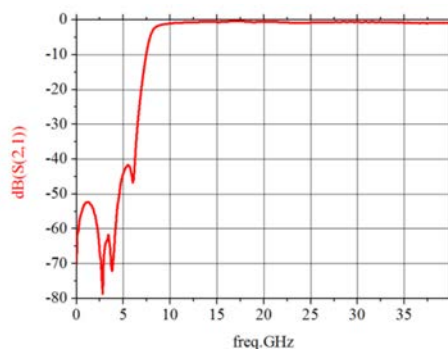
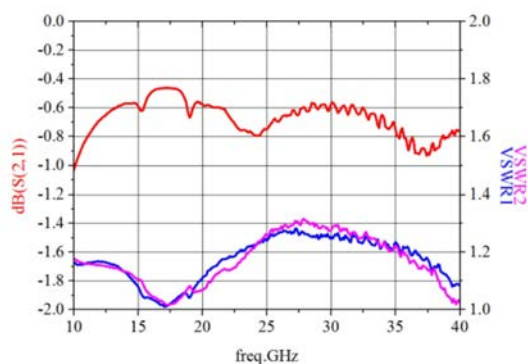
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	40000	MHz
中心损耗	/	/			1.2	dB
带外抑制	6700	MHz≥	37			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

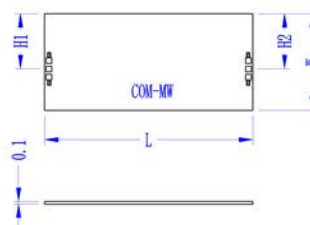
典型测试曲线图



参考实物图

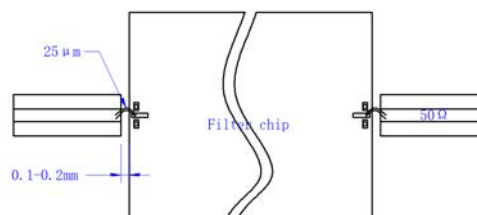


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.95	1.0	1.05
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.55	
H2		0.55	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

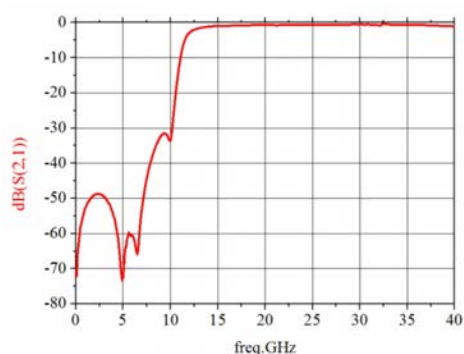
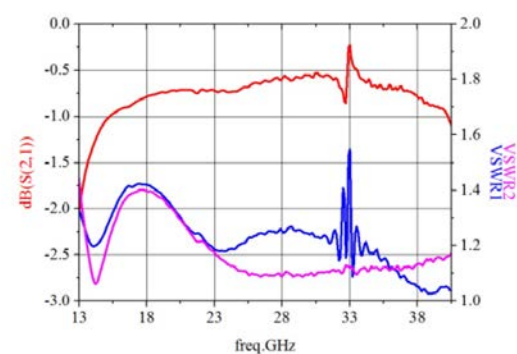
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12500	~	40000	MHz
中心损耗	/	/			2.1	dB
带外抑制	10400	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

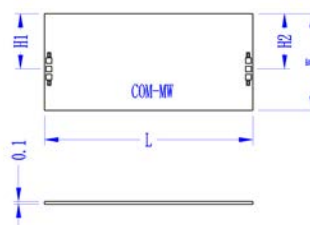
典型测试曲线图



参考实物图

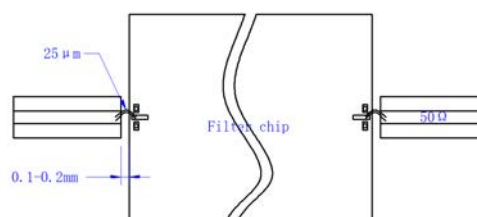


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.45	1.5	1.55
W	0.75	0.8	0.85
H1		0.35	
H2		0.35	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

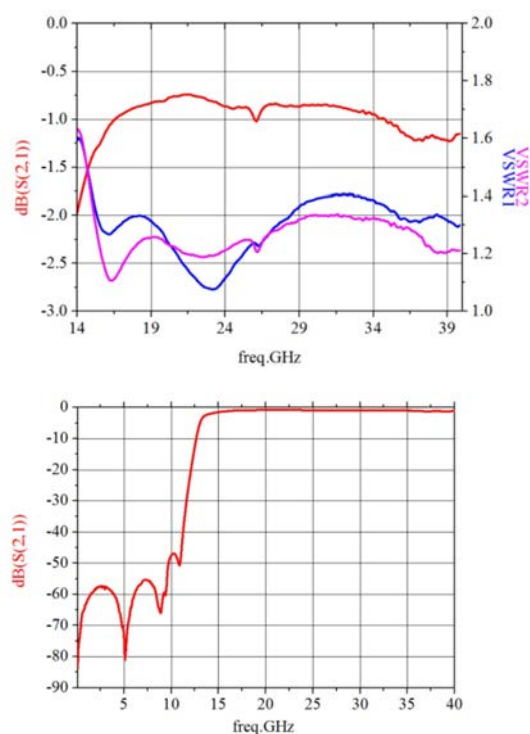
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14200	~	40000	MHz
中心损耗	/	/			2.2	dB
带外抑制	11700	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

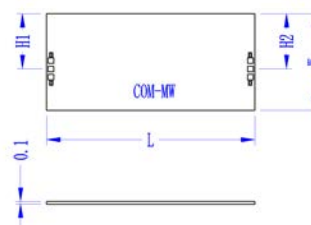
典型测试曲线图



参考实物图

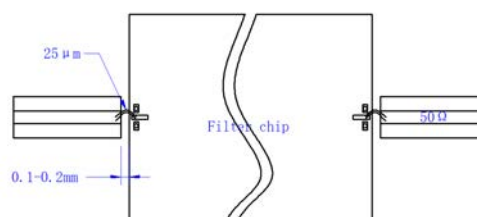


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.95	1.0	1.05
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.5	
H2		0.5	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

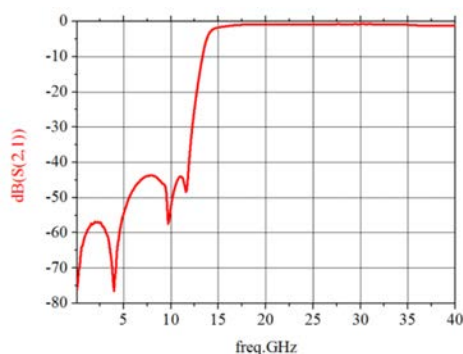
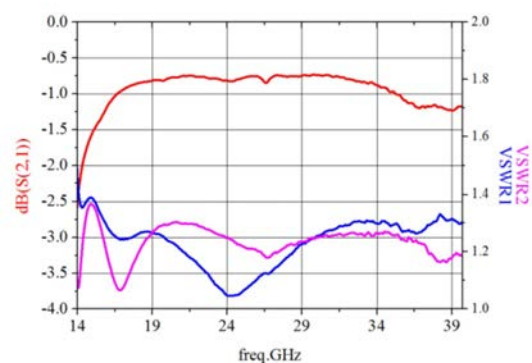
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14300	~	40000	MHz
中心损耗	/	/			2.9	dB
带外抑制	12300	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

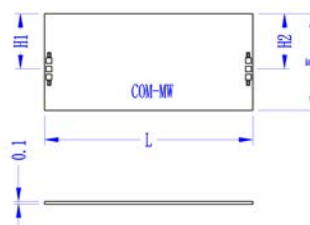
典型测试曲线图



参考实物图

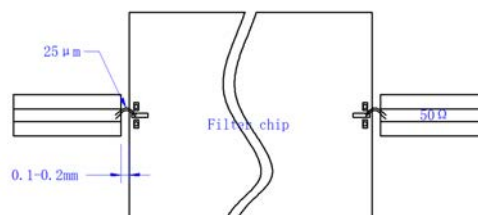


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.95	1.0	1.05
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.5	
H2		0.5	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

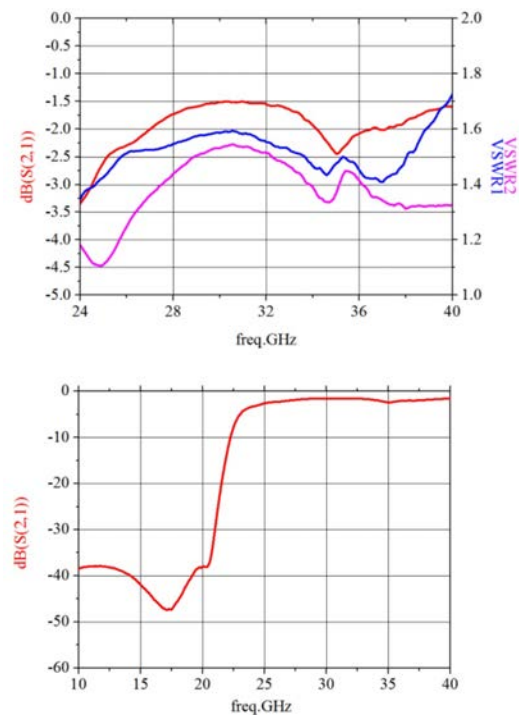
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24000	~	40000	MHz
中心损耗	/	/			3.6	dB
带外抑制	2100	MHz≥	22			dBc
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	20dBm设计保证
存储温度	-65~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

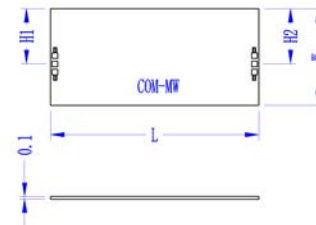
典型测试曲线图



参考实物图

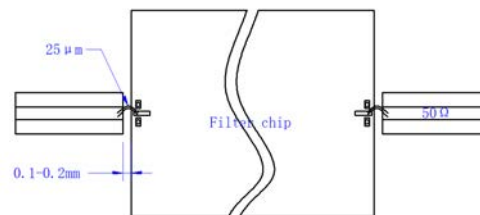


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	0.95	1.0	1.05
W	0.55	0.6	0.65
H1		0.3	
H2		0.3	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

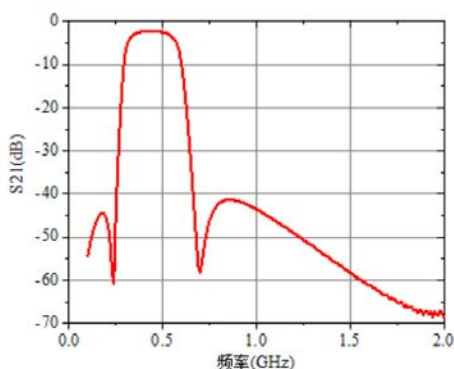
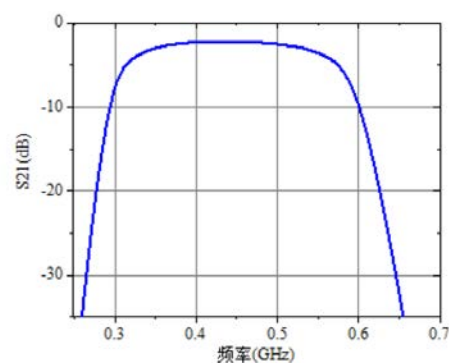
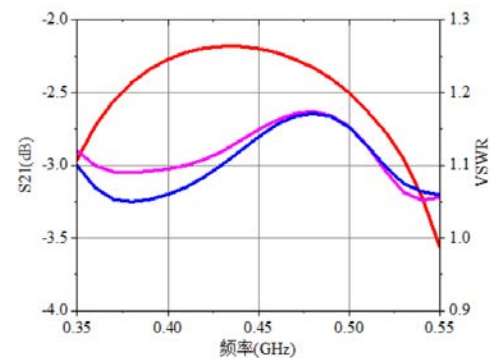
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	350	~	550	MHz
中心损耗	/	/			2.3	dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	270	MHz $\geq$	20			dBc
带外抑制	650	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

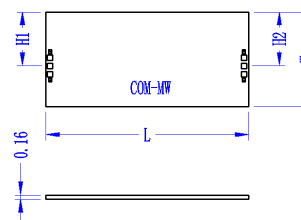
典型测试曲线图



参考实物图

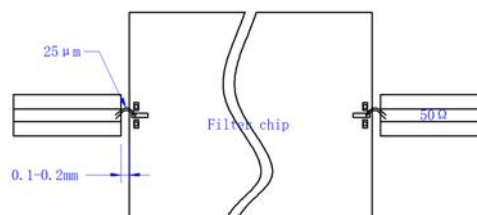


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.5	3.6	3.7
W	2.9	3.0	3.1
H1		1.09	
H2		1.09	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

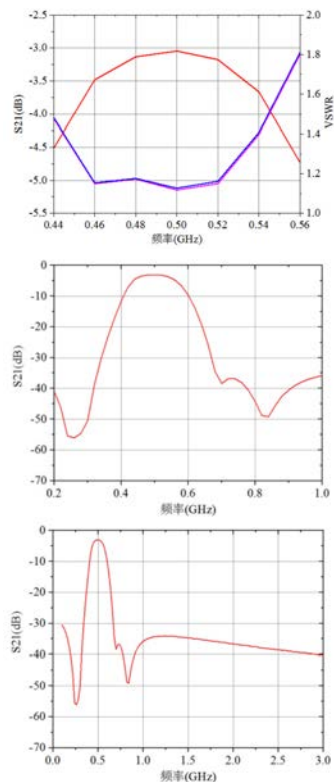
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	460	~	540	MHz
中心损耗	/	/			3.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	300	MHz≥	40			dBc
带外抑制	680	MHz≥	27			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

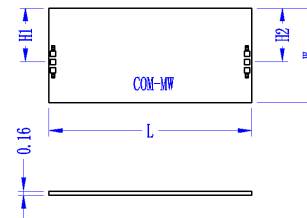
典型测试曲线图



参考实物图

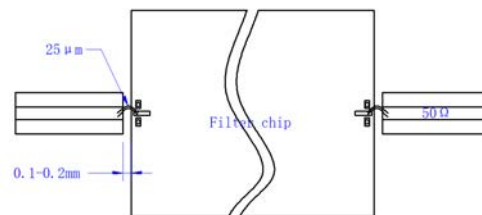


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.35	2.4	2.45
W	1.75	1.8	1.85
H1		0.9	
H2		0.9	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

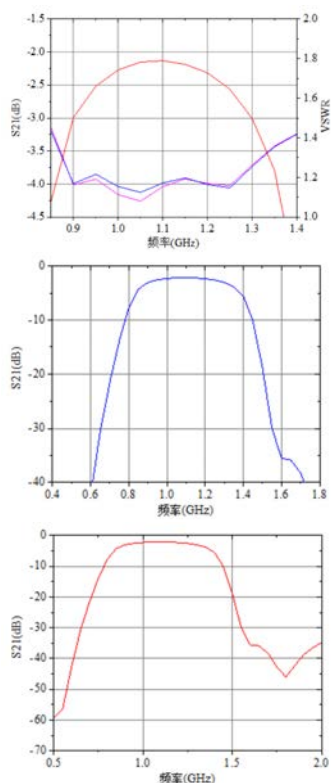
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	900	~	1250	MHz
中心损耗	/	/			2.4	dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	650	MHz $\geq$	20			dBc
带外抑制	1600	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

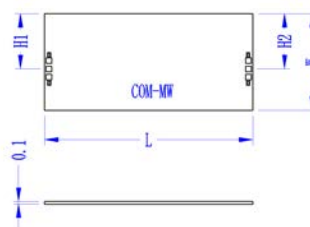
典型测试曲线图



参考实物图

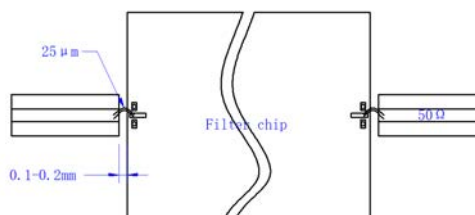


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.7	1.8	1.9
W	1.0	1.1	1.2
H1		0.5	
H2		0.5	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

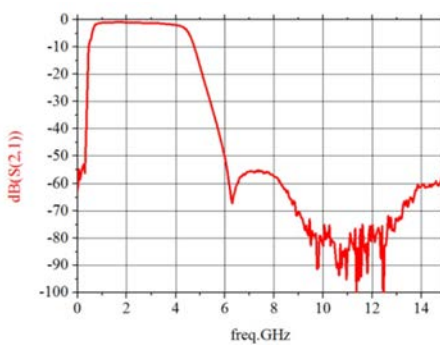
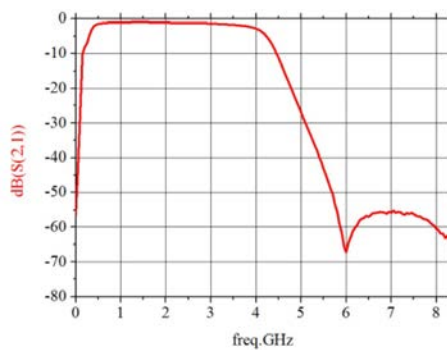
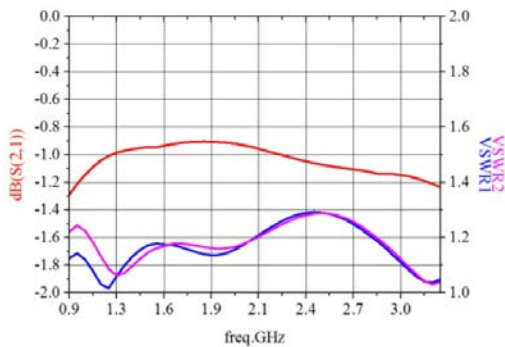
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	950	~	3300	MHz
中心损耗	/	/			1	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	400	MHz≥	40			dBc
带外抑制	6000	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

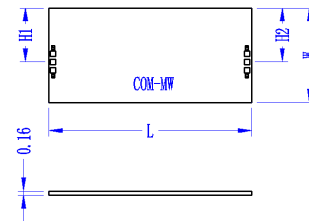
典型测试曲线图



参考实物图

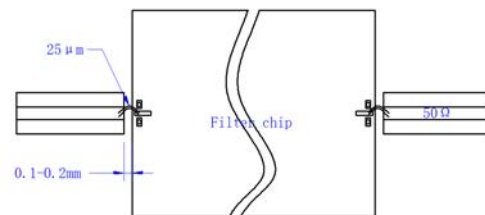


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.9	2.0	2.1
H1		1.0	
H2		1.0	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

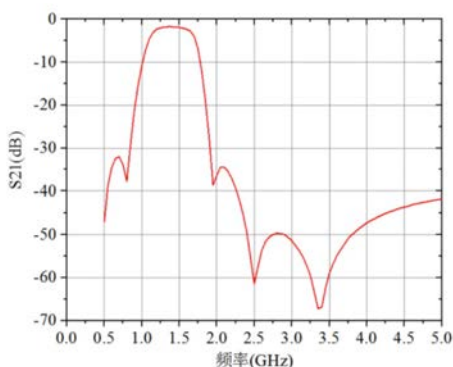
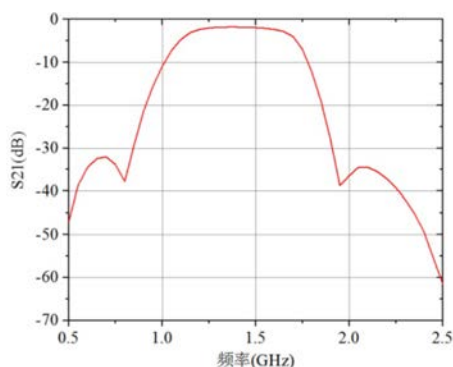
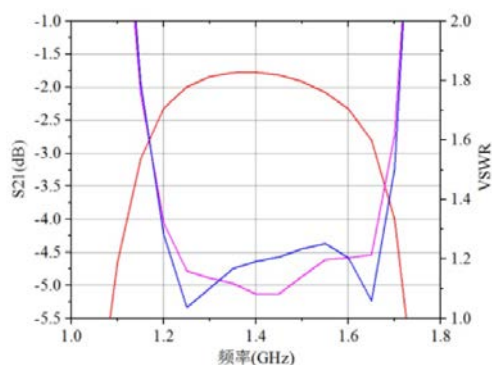
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1250	~	1450	MHz
中心损耗	/	/			1.9	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	800	MHz $\geq$	30			dBc
带外抑制	2000	MHz $\geq$	30			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

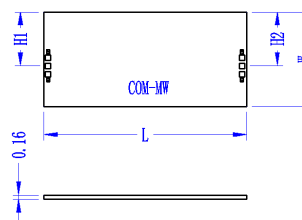
典型测试曲线图



参考实物图

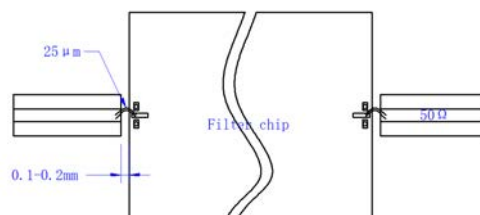


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.65	2.7	2.75
W	1.55	1.6	1.65
H1		0.77	
H2		0.77	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

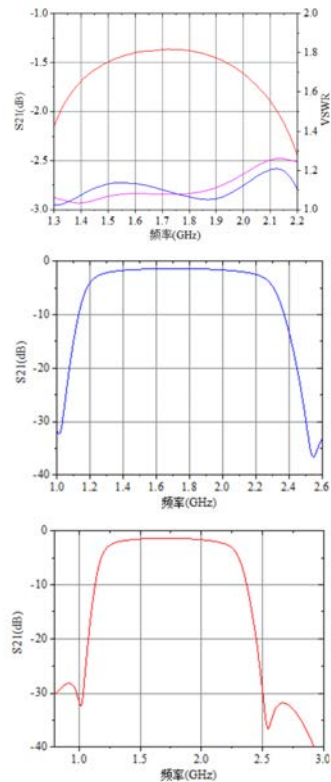
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1300	~	2150	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	1030	MHz≥	25			dBc
带外抑制	2500	MHz≥	25			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

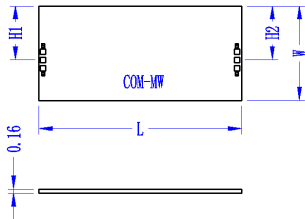
典型测试曲线图



参考实物图

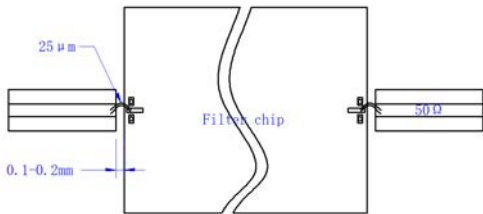


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.8	1.9	2.0
H1		0.98	
H2		0.98	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

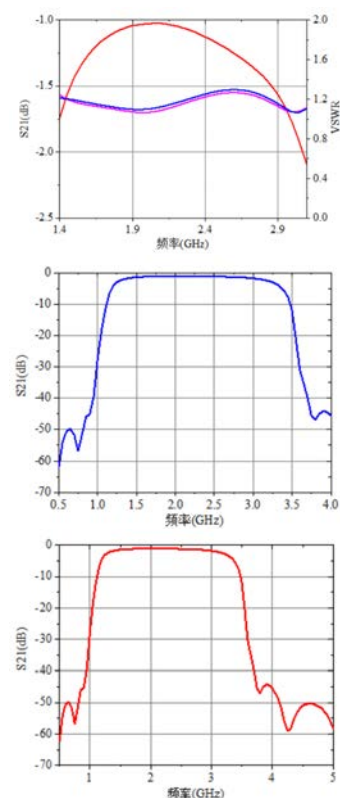
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1400	~	3050	MHz
中心损耗	/	/			1.1	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	950	MHz≥	35			dBc
带外抑制	3750	MHz≥	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

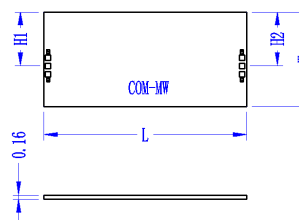
典型测试曲线图



参考实物图

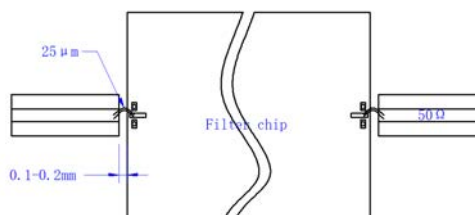


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.7	2.8	2.9
W	1.1	1.2	1.3
H1		0.6	
H2		0.6	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

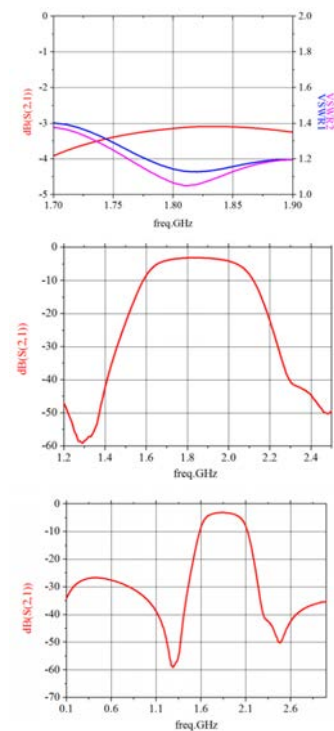
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1700	~	1900	MHz
中心损耗	/	/			3.5	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	1300	MHz≥	48			dBc
带外抑制	2300	MHz≥	34			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

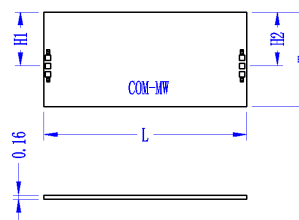
典型测试曲线图



参考实物图

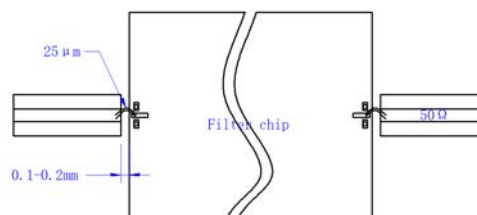


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.25	2.3	2.35
W	1.25	1.3	1.35
H1		0.65	
H2		0.65	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

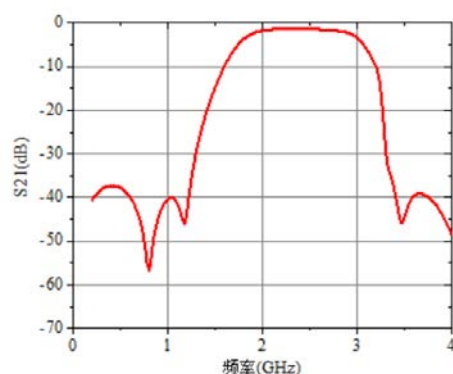
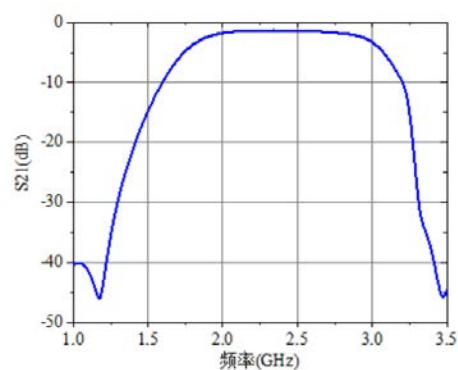
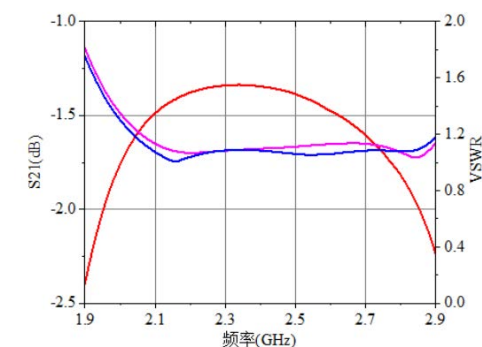
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1950	~	2850	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	1220	MHz≥	35			dBc
带外抑制	3400	MHz≥	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

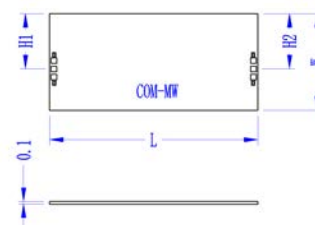
典型测试曲线图



参考实物图

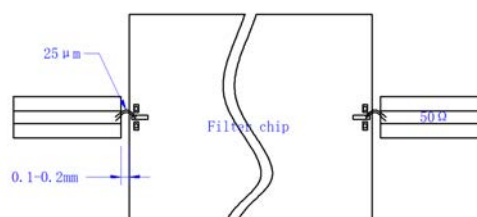


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.7	2.8	2.9
W	1.8	1.9	2
H1		0.95	
H2		0.95	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

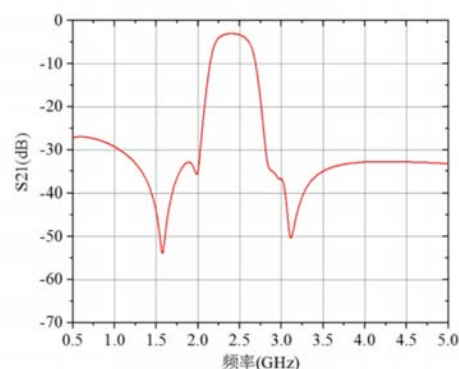
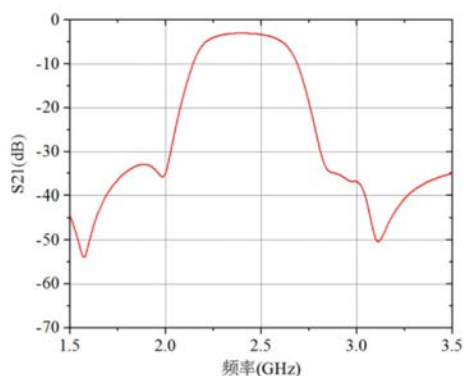
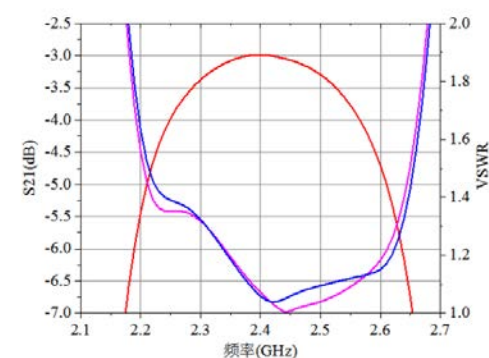
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2250	~	2550	MHz
中心损耗	/	/			3.1	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	2000	MHz≥	30			dBc
带外抑制	2900	MHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

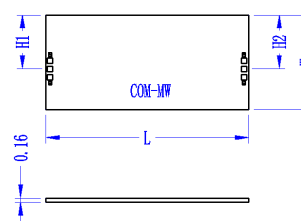
典型测试曲线图



参考实物图

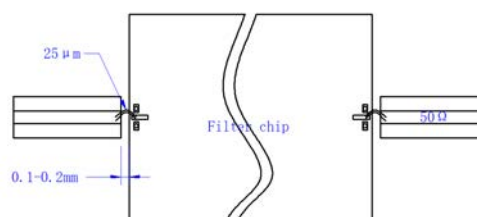


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.15	2.2	2.25
W	1.15	1.2	1.25
H1		0.55	
H2		0.55	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

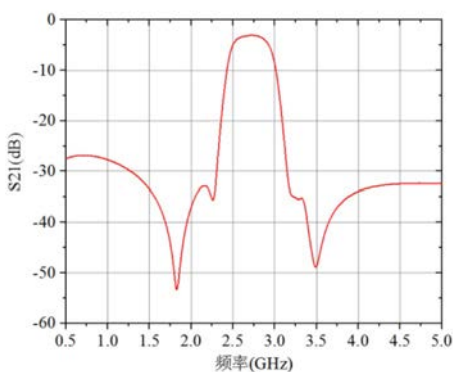
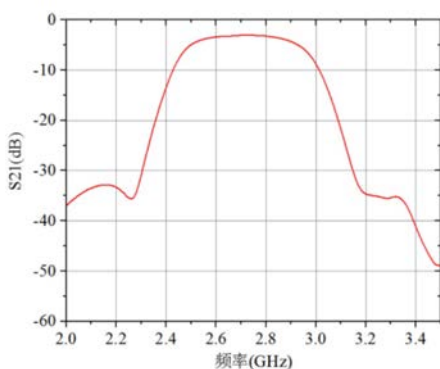
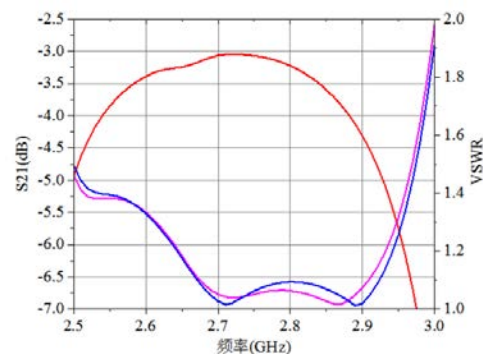
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2550	~	2850	MHz
中心损耗	/	/			3.2	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	2250	MHz≥	28			dBc
带外抑制	3200	MHz≥	28			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

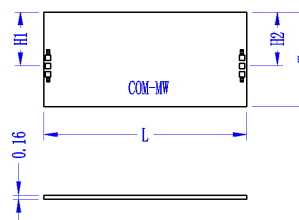
典型测试曲线图



参考实物图

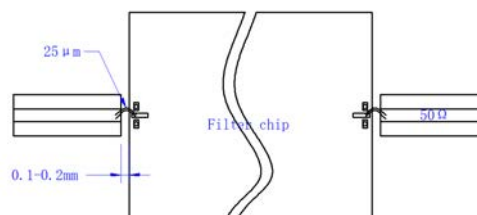


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.15	2.2	2.25
W	1.15	1.2	1.25
H1		0.55	
H2		0.55	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

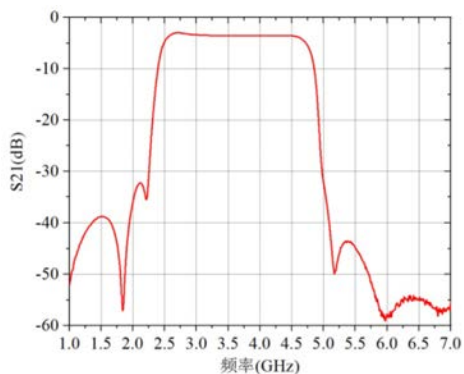
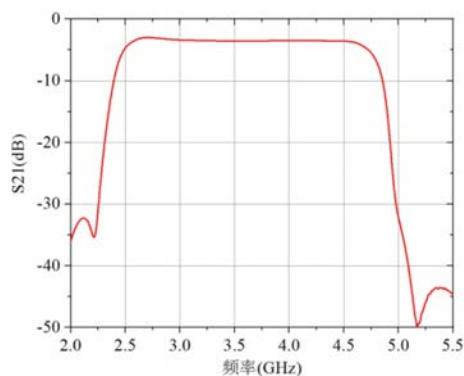
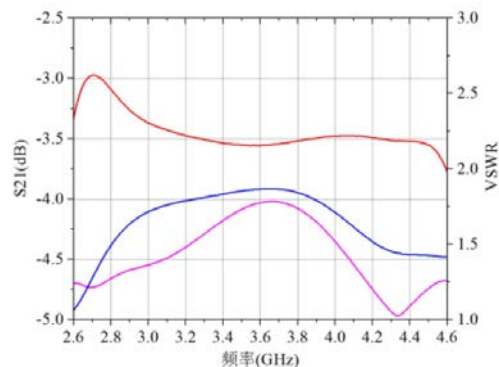
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2600	~	4600	MHz
中心损耗	/	/			3.8	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2200	MHz≥	29			dBc
带外抑制	5000	MHz≥	29			dBc
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

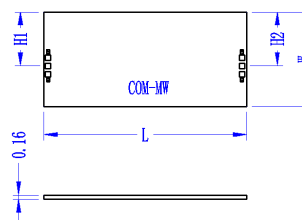
典型测试曲线图



参考实物图

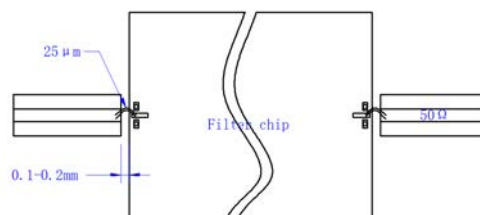


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.65	3.7	3.75
W	1.45	1.5	1.55
H1		0.85	
H2		0.85	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

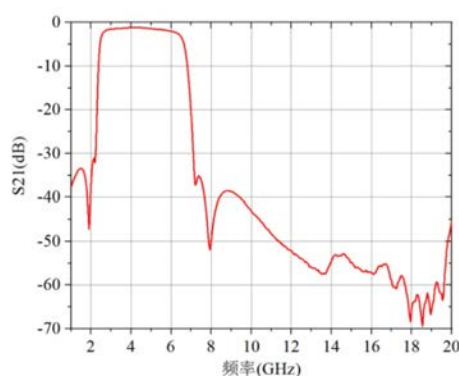
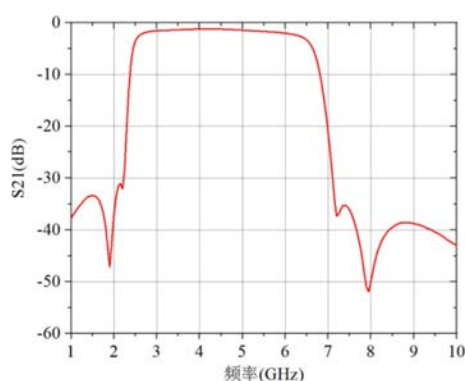
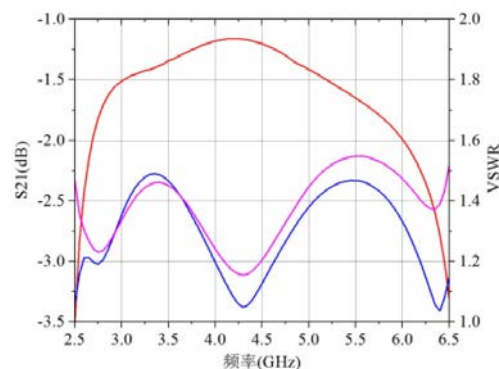
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2700	~	6200	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.7	dB
带外抑制	2200	MHz≥	23			dBc
带外抑制	7200	MHz≥	28			dBc
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

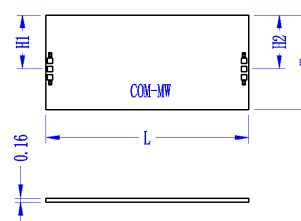
典型测试曲线图



参考实物图

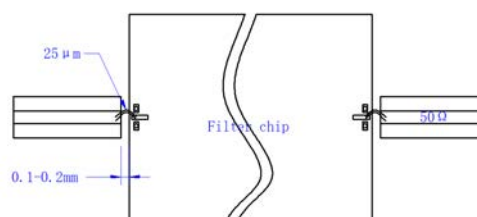


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.65	2.7	2.75
W	1.95	2	2.05
H1		1.05	
H2		1.05	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

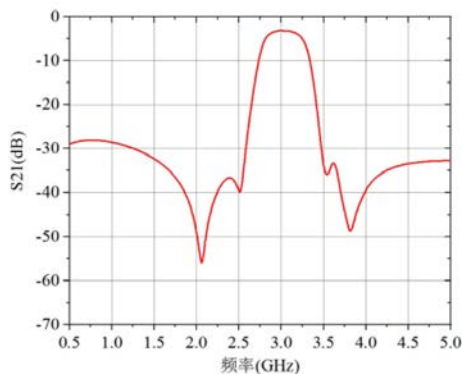
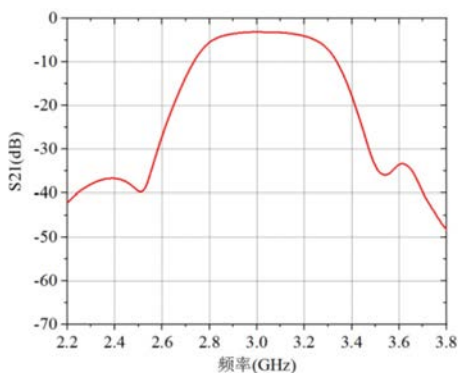
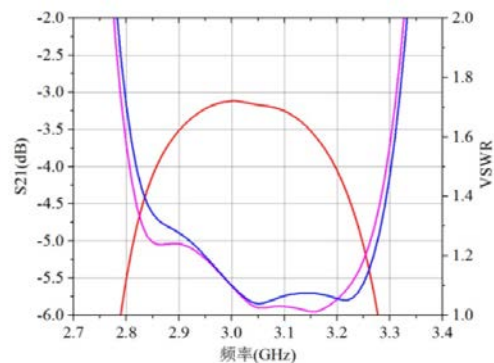
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2850	~	3150	MHz
中心损耗	/	/			3.3	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	800	MHz≥	30			dBc
带外抑制	2000	MHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

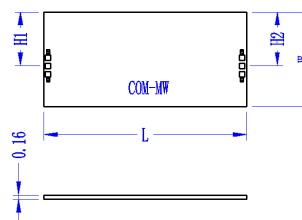
典型测试曲线图



参考实物图

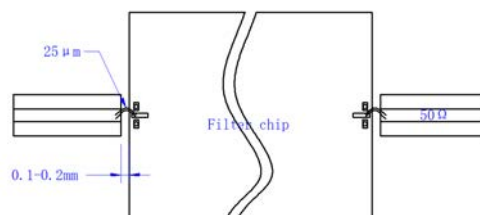


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.15	2.2	2.25
W	1.15	1.2	1.25
H1		0.55	
H2		0.55	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

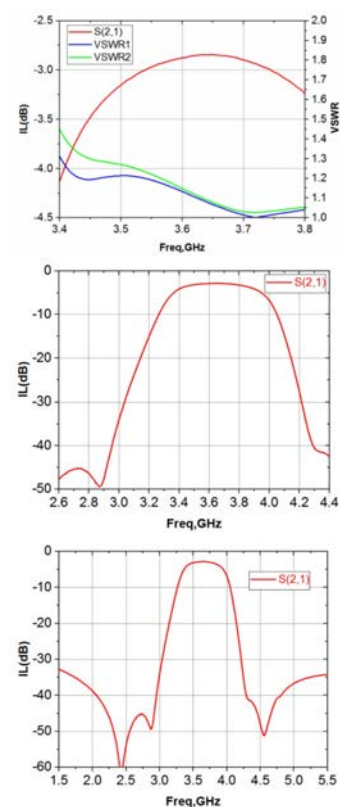
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3475	~	3725	MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2880	MHz $\geq$	43			dBc
带外抑制	4320	MHz $\geq$	37			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-65~+150 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

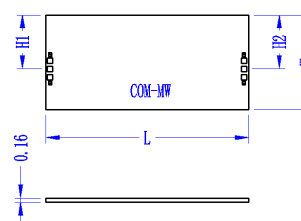
典型测试曲线图



参考实物图

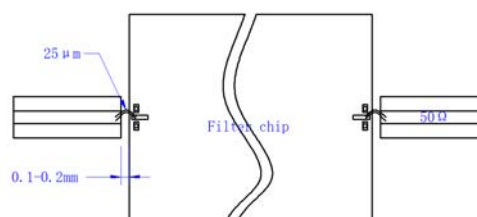


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.9	2.0	2.1
W	1.1	1.2	1.3
H1		0.55	
H2		0.55	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

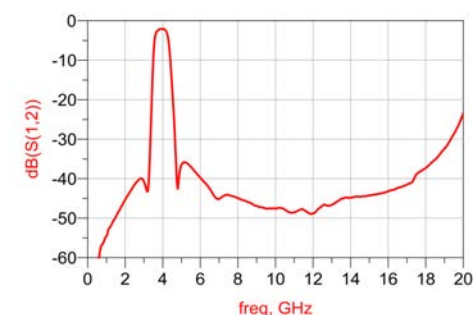
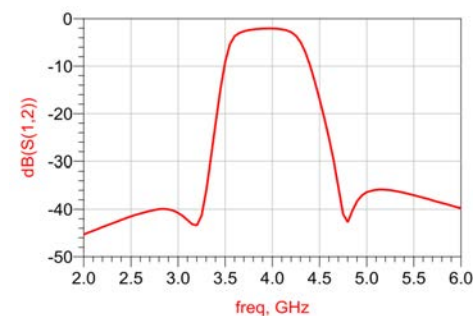
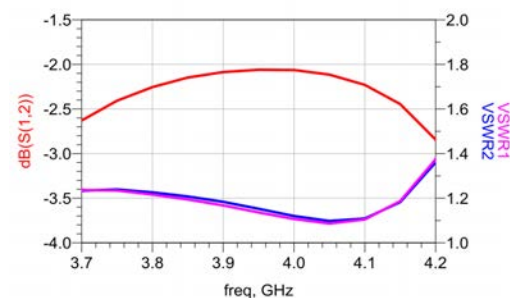
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3700	~	4150	MHz
中心损耗	/	/			2.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3350	MHz≥	20			dBc
带外抑制	4620	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

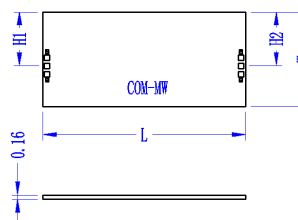
典型测试曲线图



参考实物图

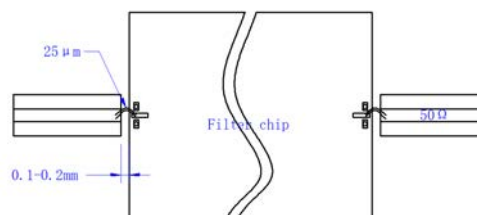


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.95	2.0	2.05
W	2.55	2.6	2.65
H1		1.45	
H2		1.45	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

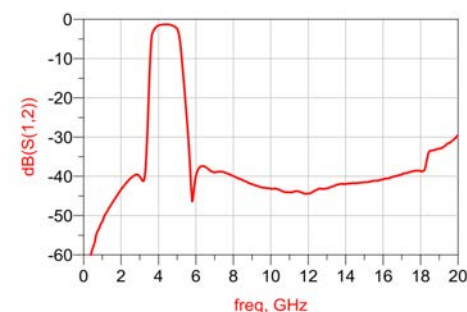
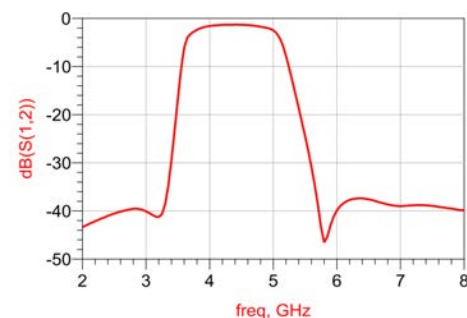
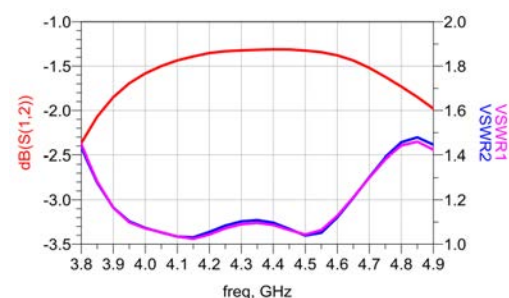
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3850	~	4900	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3400	MHz≥	20			dBc
带外抑制	5550	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

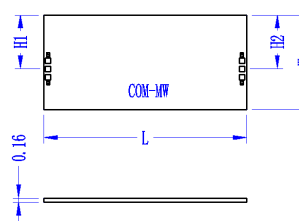
典型测试曲线图



参考实物图

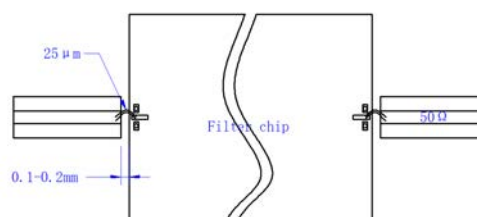


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.35	2.4	2.45
W	2.35	2.4	2.45
H1		1.25	
H2		1.25	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

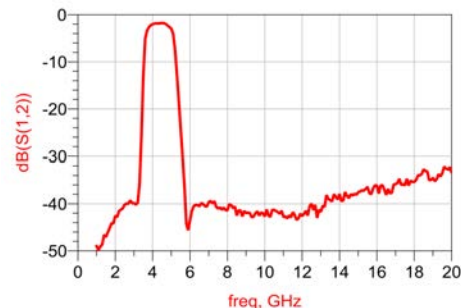
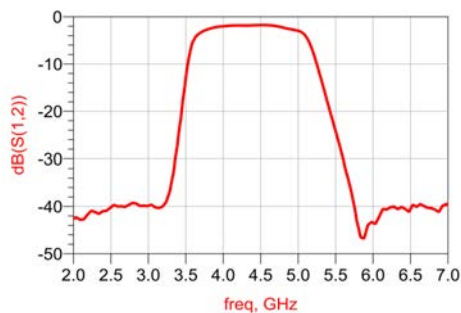
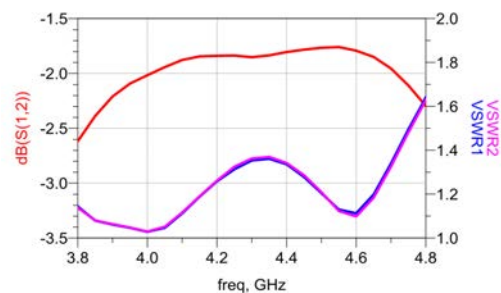
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3900	~	4800	MHz
中心损耗	/	/			1.9	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3360	MHz≥	20			dBc
带外抑制	5700	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

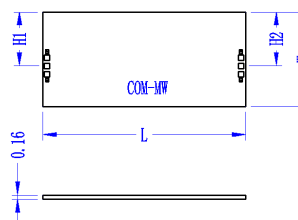
典型测试曲线图



参考实物图

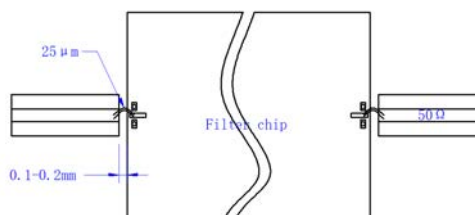


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.4	1.5	1.6
W	2.3	2.4	2.5
H1		1.25	
H2		1.25	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

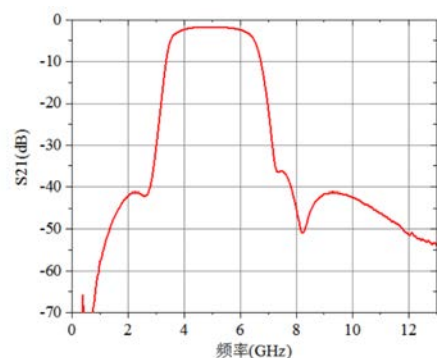
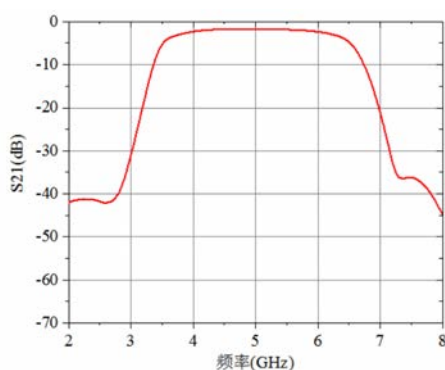
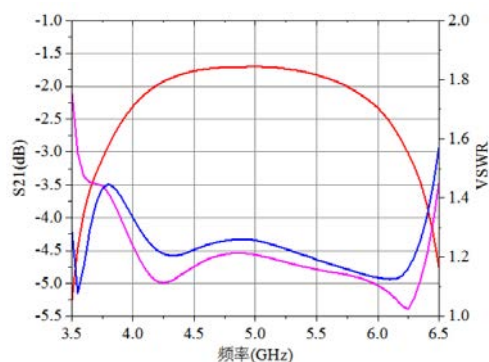
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3950	~	6050	MHz
中心损耗	/	/			1.9	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2750	MHz≥	35			dBc
带外抑制	7900	MHz≥	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

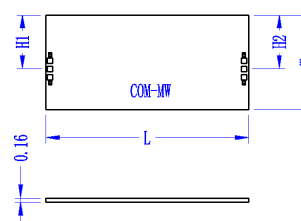
典型测试曲线图



参考实物图

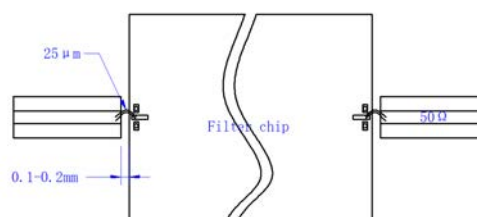


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.55	1.6	1.65
W	0.95	1.0	1.05
H1		0.33	
H2		0.33	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

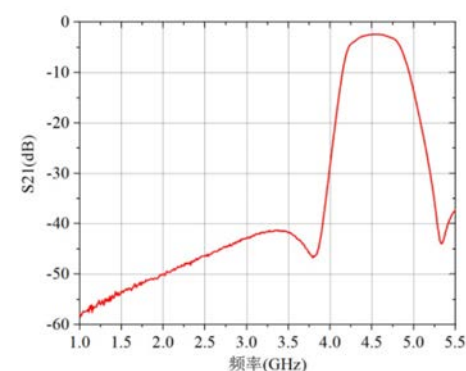
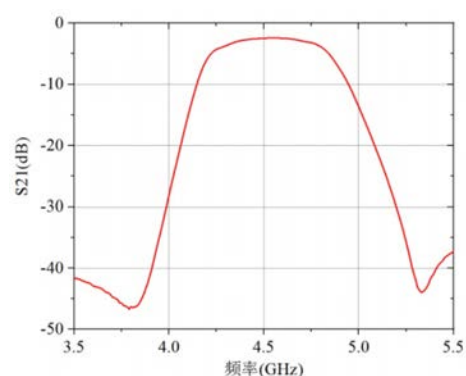
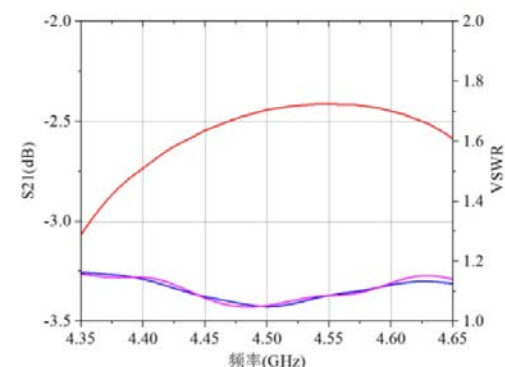
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4360	~	4640	MHz
中心损耗	/	/			2.8	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	4000	MHz≥	20			dBc
带外抑制	5000	MHz≥	10			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

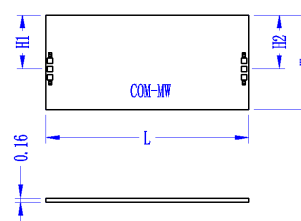
典型测试曲线图



参考实物图

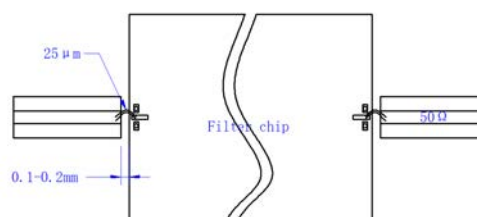


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.15	2.2	2.25
W	2.45	2.5	2.55
H1		1.35	
H2		1.35	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

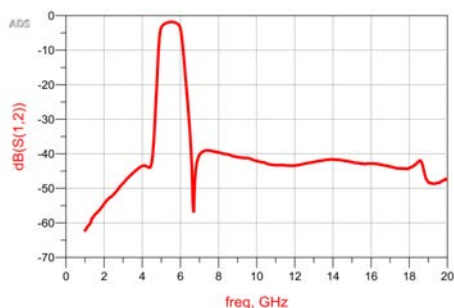
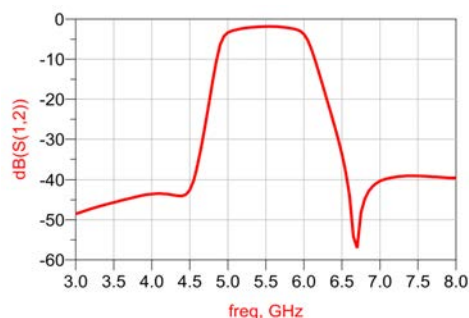
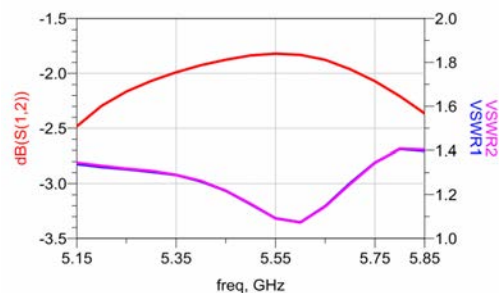
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5150	~	5850	MHz
中心损耗	/	/			2.4	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	4400	MHz≥	40			dBc
带外抑制	6600	MHz≥	35			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

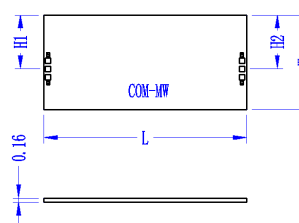
典型测试曲线图



参考实物图

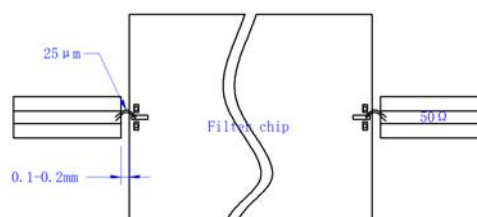


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.7	2.8	2.9
W	1.9	2.0	2.1
H1		1.04	
H2		1.04	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

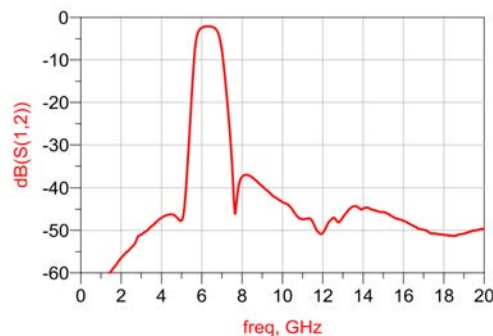
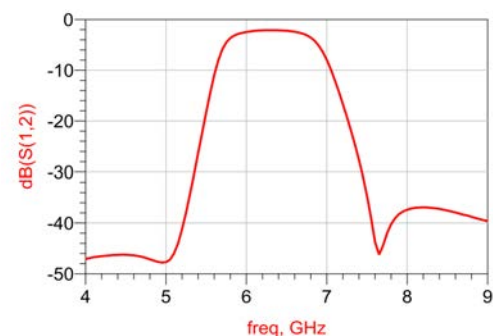
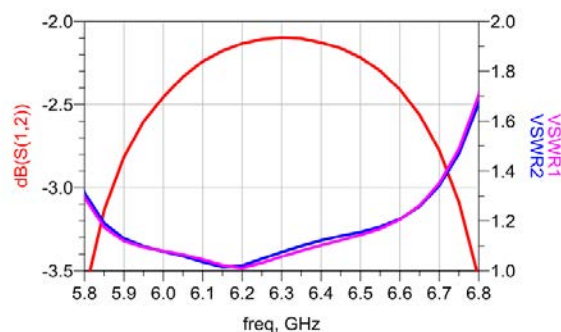
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6000	~	6600	MHz
中心损耗	/	/			2.4	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	5360	MHz≥	20			dBc
带外抑制	7400	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125°C设计保证
存储温度	-65~+150°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

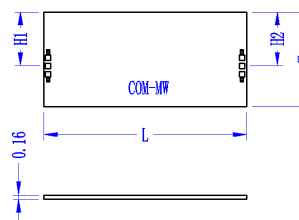
典型测试曲线图



参考实物图

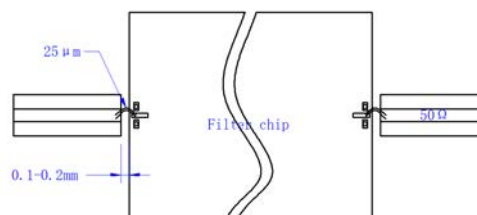


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.95	2.0	2.05
W	1.75	1.8	1.85
H1		0.9	
H2		0.9	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。

产品特点

成熟 GaAs (砷化镓) 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

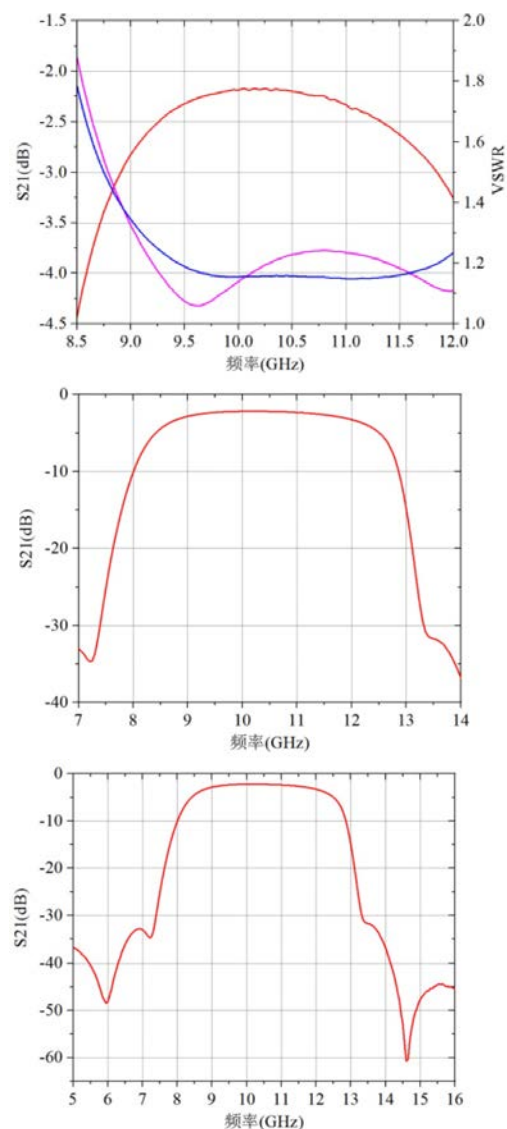
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8900	~	11800	MHz
中心损耗	/	/			2.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-7450	MHz≥	20			dBc
带外抑制	13400	MHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	25dBm设计保证
工作温度	-55~+125℃设计保证
存储温度	-65~+150℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MMIC

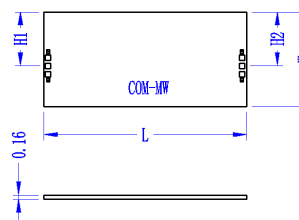
典型测试曲线图



参考实物图

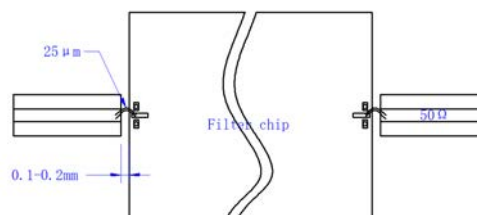


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	1.6	1.7	1.8
W	0.9	1.0	1.1
H1		0.44	
H2		0.44	

装配示意图



装配及使用说明

1. 储存: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
2. 静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
3. 常规操作: 操作过程中避免工具或手指接触芯片表面。
4. 装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
5. 烧结工艺: 使用金锡比例80/20的AuSn焊料。温度不超过295度, 摩擦时间不要超过3秒。
6. 粘接工艺: 导电胶的电胶量尽量少, 将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。
7. 键合操作: 球型或楔型键合均采用 0.025mm 金丝, 按照通用工艺进行。